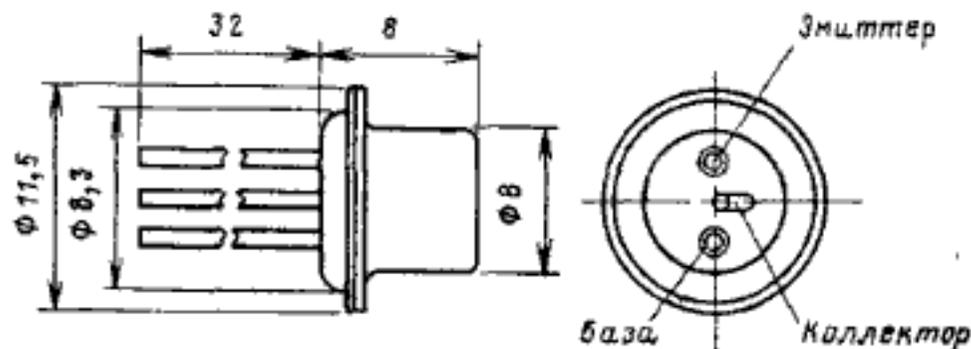


1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е, ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е

Транзисторы германиевые конверсионные *p-n-p* переключаемые высокочастотные маломощные.

Предназначены для применения в схемах переключения

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Вывод эмиттера на буртике корпуса маркируется цветной меткой. Масса транзистора не более 2,2 г.



Электрические параметры

| | |
|--|---------------|
| Граничная частота при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 15$ мА не менее | 60 МГц |
| Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 15$ мА, $f = 5$ МГц не более: | |
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 400 нс |
| ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е | 600 нс |

Время рассасывания при $I_{K \text{ нас}} = 700$ мА не более:

| | |
|---|-------|
| 1Т321А, ГТ321А, 1Т321Г, ГТ321Г при | |
| $I_{B \text{ нас}} = 70$ мА | 1 мкс |
| 1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321Д, ГТ321Д при | |
| $I_{B \text{ нас}} = 35$ мА | 1 мкс |
| 1Т321В, ГТ321В, 1Т321Е, ГТ321Е при | |
| $I_{B \text{ нас}} = 17,5$ мА | 1 мкс |

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KЭ} = 3$ В, $I_K = 500$ мА:
при $T = 293$ К:

| | |
|--------------------------|--------|
| ГТ321А, ГТ321Г | 20–60 |
| ГТ321Б, ГТ321Д | 40–120 |
| ГТ321В, ГТ321Е | 80–200 |

при $T = 298$ К:

| | |
|--------------------------|--------|
| 1Т321А, 1Т321Г | 20–60 |
| 1Т321Б, 1Т321Д | 40–120 |
| 1Т321В, 1Т321Е | 80–200 |

при $T = 213$ К 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В,
1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е

От 0,5 до 2
значений при
 $T = 298$ К

при $U_{кэ} = 8$ В, $I_{к} = 1,5$ А не менее:

| | |
|--|----|
| 1Т321А, 1Т321Г | 15 |
| 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Д, 1Т321Е | 20 |

Граничное напряжение при $T = 298 \div 343$ К,

$I_{э} = 700$ мА не менее:

| | |
|----------------------------------|------|
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В | 45 В |
| 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 35 В |

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при

$I_{к} = 700$ мА не более:

| | |
|------------------------------------|-------|
| 1Т321А, ГТ321А, 1Т321Г, ГТ321Г при | 2,5 В |
| $I_{б} = 140$ мА | |
| 1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321Д, ГТ321Д при | 2,5 В |
| $I_{б} = 70$ мА | |
| 1Т321В, ГТ321В, 1Т321Е, ГТ321Е при | 2,5 В |
| $I_{б} = 35$ мА | |

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{к} =$
 $= 700$ мА не более:

| | |
|------------------------------------|-------|
| 1Т321А, ГТ321А, 1Т321Г, ГТ321Г при | 1,3 В |
| $I_{б} = 140$ мА | |
| 1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321Д, ГТ321Д при | 1,3 В |
| $I_{б} = 70$ мА | |
| 1Т321В, ГТ321В, 1Т321Е, ГТ321Е при | 1,3 В |
| $I_{б} = 35$ мА | |

Обратный ток коллектора не более:

при $T = 293$ К:

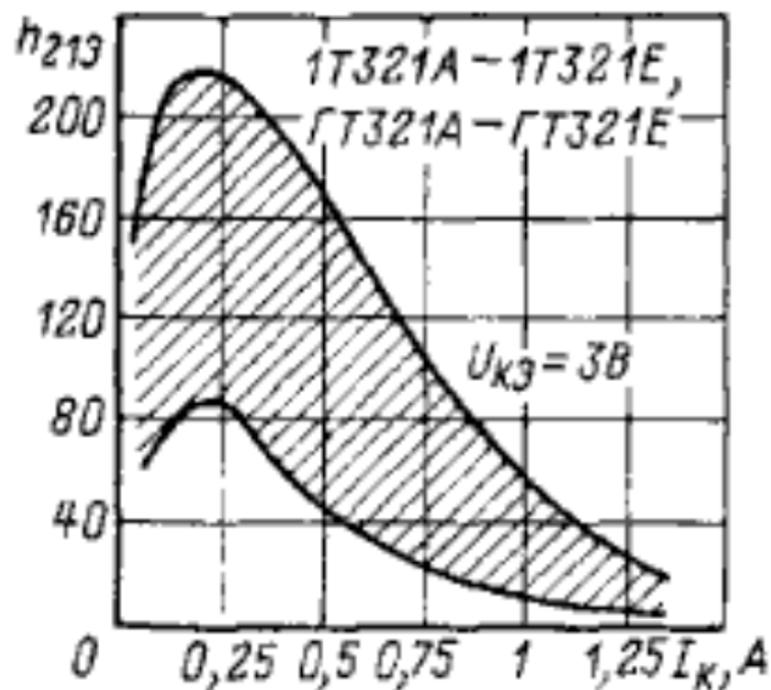
| | |
|---|---------|
| ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В при $U_{кб} =$ $= 60$ В | 500 мкА |
|---|---------|

| | |
|---|---------|
| ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е при $U_{КБ} =$ $= 45 \text{ В}$ | 500 мкА |
| при $T = 298 \text{ К}$ | |
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В при $U_{КБ} =$ $= 60 \text{ В}$ | 500 мкА |
| 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е при $U_{КБ} =$ $= 45 \text{ В}$ | 500 мкА |
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е при $U_{КБ} = 30 \text{ В}$ | 100 мкА |
| при $T = 343 \text{ К}$, $U_{КБ} = 30 \text{ В}$ 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 1,2 мА |
| Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 100 \text{ Ом}$ не более | |
| 1Т321А, ГТ321А, 1Т321Б, ГТ321Б, 1Т321В, ГТ321В, при $U_{КЭ} = 50 \text{ В}$ | 0,8 мА |
| 1Т321Г, ГТ321Г, 1Т321Д, ГТ321Д, 1Т321Е, ГТ321Е при $U_{КЭ} = 40 \text{ В}$ | 0,8 мА |
| Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$ не более | 80 пФ |
| Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5 \text{ В}$ не более | |
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 550 пФ |
| ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е | 600 пФ |

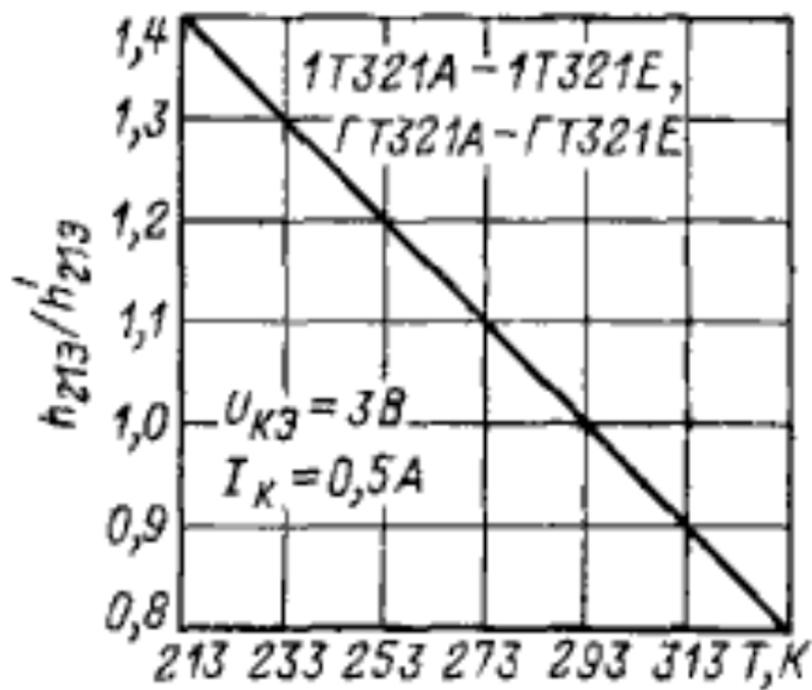
Пределные эксплуатационные данные

| | |
|---|-------|
| Постоянное напряжение коллектор-база при $T = 213 - 318$ К | |
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В | 60 В |
| 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 45 В |
| при $T = 343$ К для 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 30 В |
| Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $T = 213 - 293$ К, $R_{БЭ} \leq 100$ Ом | |
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В | 50 В |
| 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 40 В |
| Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при отключенной базе | |
| ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В | 40 В |
| ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е | 30 В |
| Постоянное напряжение эмиттер-база | |
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В | 4 В |
| 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 2,5 В |
| Импульсное напряжение коллектор-база при $\tau_n \leq 30$ мкс | |
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В | 60 В |
| 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 45 В |
| Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 100$ Ом, $\tau_n \leq 30$ мкс: | |

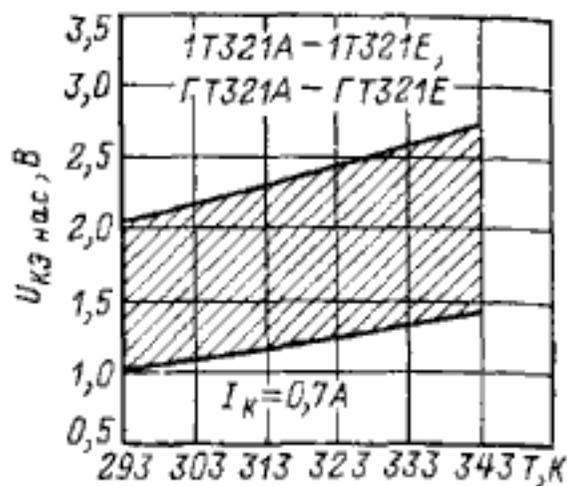
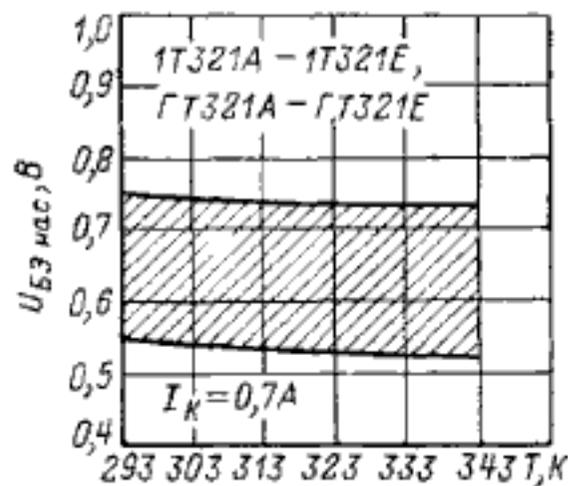
| | |
|---|-----------------|
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В | 50 В |
| 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 40 В |
| Постоянный ток коллектора | 200 мА |
| Постоянный ток базы | 30 мА |
| Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 30$ мкс | |
| при $T \leq 318$ К | 2 А |
| при $T = 333$ К | 1,64 А |
| при $T = 343$ К 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 1,5 А |
| Импульсный ток базы при $\tau_n \leq 30$ мкс | 0,5 А |
| Постоянная рассеиваемая мощность | |
| при $T \leq 318$ К | 160 мВт |
| при $T = 333$ К | 100 мВт |
| при $T = 343$ К 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 60 мВт |
| Импульсная рассеиваемая мощность при $\tau_n \leq 30$ мкс | |
| при $T \leq 318$ К | 20 Вт |
| при $T = 333$ К | 15,2 Вт |
| при $T = 343$ К 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 12 Вт |
| Общее тепловое сопротивление* 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 250 К/Вт |
| Температура перехода | |
| ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е | 353 К |
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | 358* К |
| Температура окружающей среды | |
| 1Т321А, 1Т321Б, 1Т321В, 1Т321Г, 1Т321Д, 1Т321Е | От 213 до 343 К |
| ГТ321А, ГТ321Б, ГТ321В, ГТ321Г, ГТ321Д, ГТ321Е | От 218 до 333 К |



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

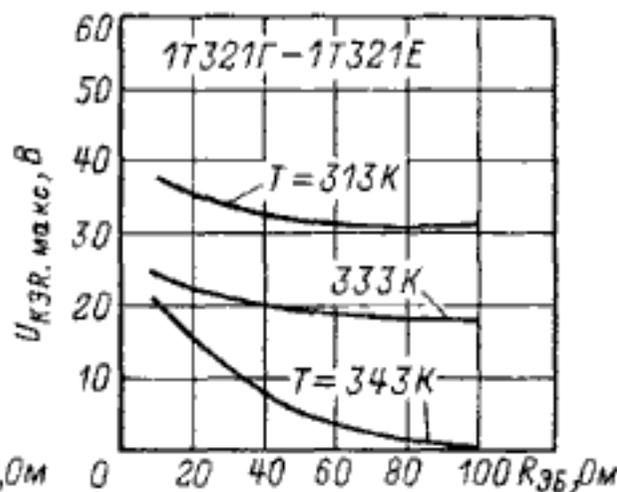
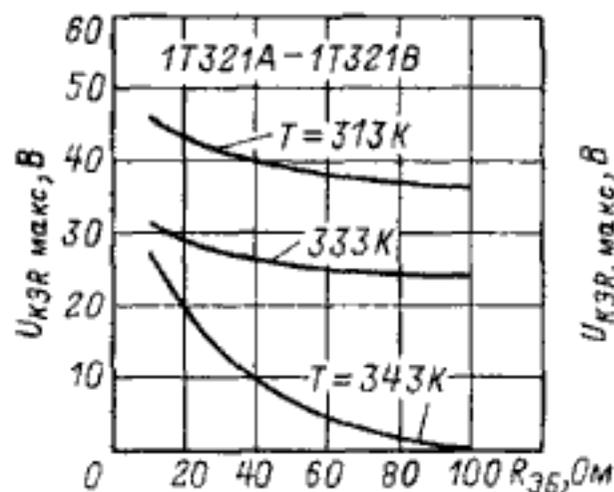


Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от температуры



Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база-эмиттер от температуры

Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры.



Зависимость максимально допустимого постоянного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления в цепи база-эмиттер.

Зависимость максимально допустимого постоянного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления в цепи база-эмиттер.